

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0205U006419

Державний реєстраційний номер: 0105U006929

Відкрита

Дата реєстрації: 02-11-2005



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вивчення процесів збудження електронних станів GaAs(111) повільними електронами та дослідження його електронної енергетичної структури методом спектроскопії зворотного розсіювання електронів низьких енергій.

Початок етапу: 11-2004

Закінчення етапу: 10-2005

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Інститут електронної фізики Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540008

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: 88017, Україна, м. Ужгород, вул. Університетська, 21

Телефон: 43668

Інше: 43650

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00027677

Адреса: 03135, м. Київ, проспект Перемоги, 10

Підпорядкованість: Кабінет міністрів

Телефон: 246-39-29

E-mail: mail@dffd.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ GaAs ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ

Назва роботи (англ)

EXCITATION OF GaAs ELECTRON STATES BY SLOW ELECTRONS

Реферат (укр)

Методом спектроскопії зворотного розсіювання повільних моноенергетичних електронів досліджено процеси пружного та непружного розсіювання електронів поверхнею n-GaAs(111). Встановлено, що як для енергетичних залежностей інтенсивності пружного розсіювання, так і для спектрів енергетичних втрат характерна багата тонка структура, обумовлена збудженням поверхневих і об'ємних електронних станів та домішкових рівнів дослідженого об'єкту.

Реферат (англ)

Backscattering spectroscopy of low-energy monoenergetic electrons was applied to study elastic and inelastic scattering of electrons by n-GaAs(111) surface. Both energy dependences of elastic scattering intensity and energy loss spectra are shown to be characterized by a rich fine structure due to the excitation of surface and bulk electron states and impurity levels of the object under investigation.

Індекс УДК: 539.182/.184;535.33/.34, 539.186, 539.188

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.29.15

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Кізман Л.А., Фейер В.М., Попик Т.Ю. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фізика. Вип. 17. -2005. С.131-136.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 22

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості

Керівник організації:

Шпеник Отто Бартоломійович

Керівники роботи:

Фейер Віталій Михайлович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.